



# **BD137: Transistor NPN Epitaxial Silicon 60V 1A**



# Descripción

**Nombre:** TRANSISTOR NPN EPITAXIAL SILICON **Referencia:** BD137

- Polaridad del transistor: NPN
- Configuración: Single
- Corriente CC máxima de colector: 1A
- Máx. voltaje VCEO colector-emisor: 60V
- Tensión VCBO colector-base: 60V
- Voltaje VEBO emisor-base: 5V
- Voltaje de saturación colector-emisor: 0.5V
- Dp - Disipación de potencia: 12W
- Producto para ganar Ancho de banda fT: 50 MHz
- Temperatura de trabajo: desde 0°C hasta 150°C

**Marca:** ASI **Empaque:** TO-126 **Precio por:** Unidad **Ficha Técnica:** [BD137 \(por Fairchild\)](#)

## Información del producto

**Descripción:** TRANSISTOR NPN EPITAXIAL SILICON ASI Referencia: BD137. El BD137 es un transistor NPN de propósito general, encapsulado en TO-126, con una tensión de ruptura colector-base (VCEO) de 60V y una corriente continua máxima del colector (IC) de 1A. Se caracteriza por su alta ganancia de corriente y su capacidad para operar a altas frecuencias, lo que lo hace ideal para aplicaciones de conmutación y amplificación.

**Precio:** \$2.187 IVA INCLUIDO

**SKU:** 9-5-145

**Categorías:** [SEMICONDUCTORES](#), [TRANSISTORES Y REGULADORES](#)

**Etiquetas:** [0090005000145](#), [9-5-145](#), [ASI](#), [BD137](#), [datasheet](#), [pinout](#), [SEMICONDUCTORES](#), [Through Hole](#), [TRANSISTOR NPN EPITAXIAL SILICON](#), [TRANSISTORES Y REGULADORES](#)